Silicon PNP Transistor

BC224

30V / 30mA / 250mW

DATASHEET

OEM – Texas Instruments

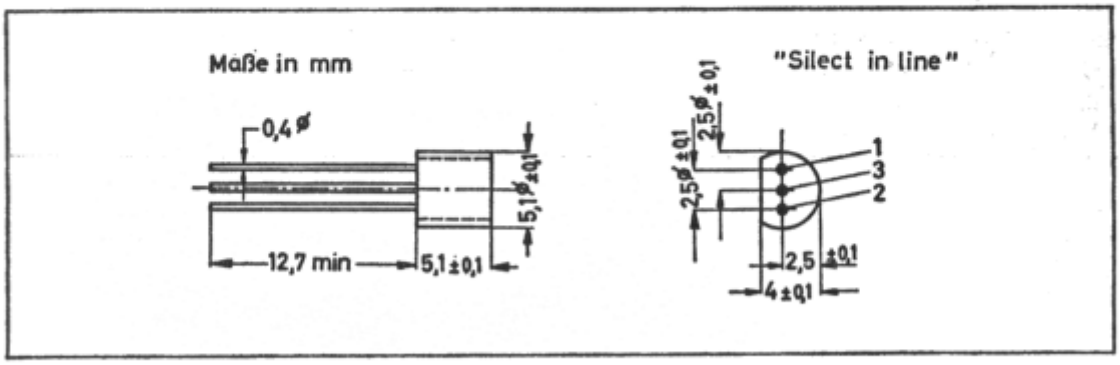
Source: Texas Instruments Databook 1968/69

Datasheet Rev. 1.3 – 03/19 – data without warranty / liability

PNP-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor im Silect*-Gehäuse BC224

Besonders geeignet für NF-Vorstufen und Treiberstufen

Mechanische Data



1 — Basis, 2 — Emitter, 3 — Kollektor

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Gehäuse eingekapselt. Das Gehäuse widersteht Löttemperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen ausgezeichnet stabile Kennwerte und erfüllen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 106B.

Absolute Grenzwerte**

Kollektor-Basis-Spannung	—30 V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1)	—30 V
Emitter-Basis-Spannung	—6 V
Kollektor-Dauerstrom	—30 mA
Gesamtdauerverlustleistung bei (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 2)	250 mW
Lagertemperatur	—55 °C bis + 150 °C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehäuse für 10 s	260 °C

Bemerkungen:

1. Dies gilt bei offener Basis.
2. Fällt linear bis zur Umgebungstemperatur von 150 °C ab; Ableitungskonstante 2 mW/°C.

* Schutzmarke von Texas Instruments.
** Vorläufige Daten.

Elektrische Kennwerte bei $T_U = 25\,°C$

Parameter		Prüfbedingungen	min	max	Einh.
$U_{(BR)CEO}$	Kollektor-Emitter-Sperrspannung	$I_C = -1$ mA, $I_B = 0$	−30		V
I_{CBO}	Kollektor-Basis-Reststrom	$U_{CB} = -20$ V, $I_E = 0$		−100	nA
I_{EBO}	Emitter-Basis-Reststrom	$U_{EB} = -6$ V, $I_C = 0$		−100	nA
h_{FE}	Gleichstromverstärkung	$U_{CE} = -5$ V, $I_C = -1$ mA	150	450	
h_{21e}	Kleinsignal-Stromverstärkung	$U_{CE} = -5$ V, $I_C = -1$ mA, f = 1 kHz	150	800	
U_{BE}	Basis-Emitter-Spannung	$U_{CE} = -5$ V, $I_C = -1$ mA	−0,5	−1	V
$U_{CE(sat)}$	Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$I_B = -0{,}5$ mA, $I_C = -10$ mA		−0,7	V